

Облікова картка ДіР



I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0212U002467

Державний реєстраційний номер: 0111U005422

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 29-02-2012

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Відпрацювання технології нарощування епітасійних структур n-InP/n+-InP/n++-InP на поверхні нанопористих підкладок під впливом рідкоземельних елементів та дослідження їх параметрів. Розроблення рекомендацій щодо застосування результатів НДР.

Початок етапу: 06.2011

Закінчення етапу: 12.2011

Вид звітного документа: Остаточний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Науково-виробниче підприємство "Карат"

Код за ЄДРПОУ: 23273999

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство промислової політики України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (032)2422021, (032)2949735

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державний науково-дослідний центр "Фонон"

Код за ЄДРПОУ: 13675648

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Публічне акціонерне товариство "Науково-виробничий концерн "Наука"

Код за ЄДРПОУ: 25594064

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління:

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон:

Внесок співвиконавця у звітний етап:

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2071730

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрямок фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 5031080

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 2100

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

"Розроблення фізико-хімічних основ технології отримання наноструктур для НВЧ-приладів з використанням модифікуючого впливу рідкоземельних елементів"

Назва роботи англійською:

"Development of physical and chemical bases of nanostructures obtaining technology for HBЧ devices using modifying influence of rare earth elements"

Реферат українською:

Проведено розробку технології виготовлення епітаксійних структур на основі InP для діодів Гана. Виготовлено експериментальні зразки епітаксійних структур

Реферат англійською:

Developing technology of epitaxial structures based on InP diodes for Gana. Made experimental samples of epitaxial structures.

Індекс УДК: 621.315.1/.3, 621.315

Коди тематичних рубрик: 45.47.02

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Круковський Семен Іванович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: "Технології отримання наноструктур для НВЧ-приладів з використанням модифікуючого впливу рідкоземельних елементів"

Назва НТП англійською: Nanostructures obtaining technology for HB devices using modifying influenct of rare earth elements.

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: Електронне приладобування

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: Розроблені фізико-хімічні основи технології виготовлення епітаксійних структур на основі InP для діодів Гана, на нанопористих підкладках, методом газофазної трихлоридної епітаксії. Епітаксійні структури характеризуються низькою густиною дефектів в активному шарі та на границі розділу фаз. Структури призначені для виготовлення височастотних діодів, які використовуються при виготовленні медичної діагностичної та фізіотерапевтичної апаратури, різноманітної навігаційній та апаратури зв'язку, спеціального обладнання для моніторингу оточуючого середовища.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2012-2013рр.

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: НДІ "Оріон", ЦКБ "Арсенал", НВО "Сатурн"

Перспективні ринки: країни СНД.

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 1500

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обґрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 900

Очікуваний термін окупності (років): 3

Додаткова інформація: Використання технології

IX. Бібліографічний опис

Х. Заключение відомості

Керівник юридичної особи

Ваків Микола Михайлович

Д. Т. Н.

Перелік осіб-виконавців

Балюк Л.М.

Тимчишин В.Р.

**Відповідальний за підготовку
облікових документів**

Телефон

Реєстратор

**Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є
відповідальним за реєстрацію наукової
діяльності**

